



Установка автоматического контроля топологии фотошаблонов ЭМ-602ЭАМ

Предназначена для автоматического обнаружения дефектов топологии фотошаблонов, используемых для производства интегральных микросхем при проекционной литографии в масштабе 10:1 и 5:1. Контроль производится методом сравнения с проектными данными. Размеры минимальных обнаруживаемых дефектов составляют 0,7×0,7 мкм и 0,5×1,0 мкм при вероятности обнаружения 0,95.

Производительность контроля:

в режиме высокой кратности 2,5 мм²/с (1 ч 10 мин по полю 100×100 мм)

в режиме средней кратности 5,0 мм²/с (35 мин по полю 100×100 мм)

в режиме низкой кратности 15,0 мм²/с (12 мин по полю 100×100 мм)

Типоразмеры шаблонов
3×3" (76×76 мм)
4×4" (102×102 мм)
5×5" (127×127 мм)
6×6" (153×153 мм)
7×7" (178×178 мм)

Размеры рабочего поля 153×153 мм

